



Thème : Dipôle électrostatique – Conduction électrique

Mardi 21 janvier 2025

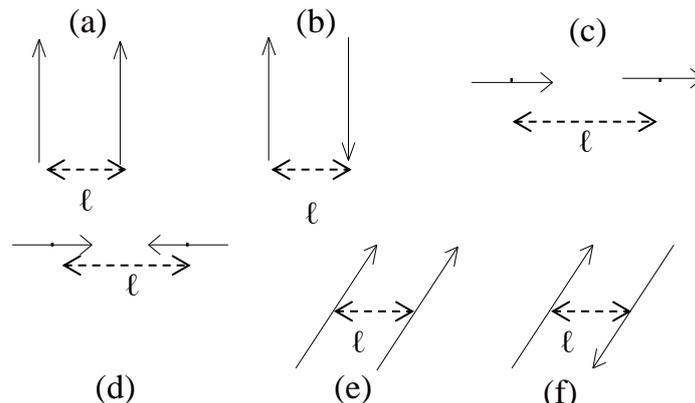
Dipôle électrostatique

EM302 – Interaction entre dipôles

Les couples de dipôles ci-dessous sont tous distants de ℓ .

Calculer dans chaque cas l'énergie potentielle du système. On posera $U_0 = \frac{p^2}{4\pi\epsilon_0\ell^3}$.

Quelle est la position la plus stable ?



cas e) et f) : dipôle à 45° par rapport à la verticale

EM304 – Interaction dipôle-dipôle (Héloïse / Ekain)

1 - Soient deux dipôles \vec{p}_0 et \vec{p} portés par l'axe Ox, respectivement en O et P.

$$\vec{OP} = x \cdot \vec{i} \quad \text{et} \quad (\vec{i}; \vec{p}_0) = (\vec{i}; \vec{p}) = 0$$

a - Donner l'expression de la force d'interaction dipôle-dipôle.

b - Calculer l'énergie de retournement du dipôle \vec{p} dans le champ créé par \vec{p}_0 comme la variation d'énergie de \vec{p} pour passer de $(\vec{p}_0; \vec{p}) = 0$ à $(\vec{p}_0; \vec{p}) = \pi$.

2 - Soient deux dipôles \vec{p}_0 et \vec{p} , respectivement en O et P. \vec{p}_0 est centré en O et de direction Oz, \vec{p} est centré en P (r, θ) (coordonnées sphériques) tel que $\vec{OP} = r \cdot \vec{e}_r$ et $(\vec{e}_r; \vec{p}) = \alpha$ dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

a - Exprimer l'énergie potentielle d'interaction dipôle-dipôle E_p en fonction de $p_0, p, r, \epsilon_0, \alpha$ et θ .

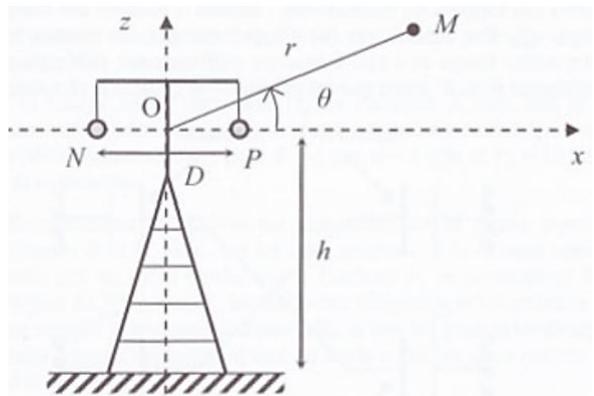
b - En supposant r et θ fixes, mais α variable, quelle est la position d'équilibre du système ?

EM310 – Ligne bifilaire (Dante / Tancède)

On considère deux câbles N et P montés sur des pylônes de hauteur $h = 15 \text{ m}$. Les câbles sont supposés de longueur infinie, de rayon $R = 3,0 \text{ cm}$ et séparés d'une distance $D = 3,0 \text{ m}$ considérée grande devant R . Les câbles sont portés à des potentiels opposés et le câble P est au potentiel V_0 . On montre alors que la charge linéique portée par ce

dernier est
$$\lambda = \frac{\epsilon_0 V_0}{\ln\left(\frac{D}{R}\right)}$$

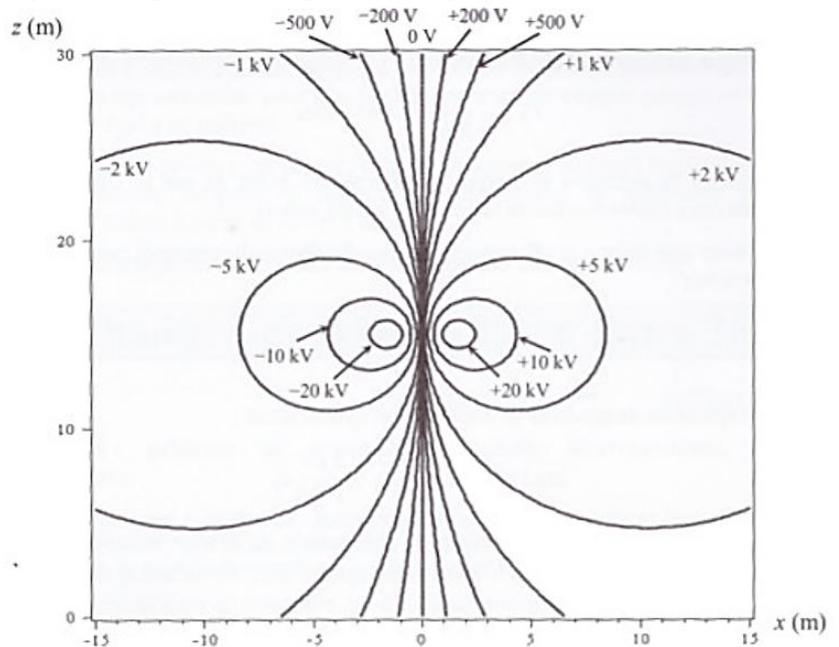
Le câble N porte une charge linéique opposée.



On considère un point M repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) , l'origine O étant placée au milieu du segment NP.

- 1 – Calculer le potentiel $V_P(M)$ généré en M par le câble P seul, en fonction de λ , ϵ_0 et PM .
- 2 – En déduire l'expression du potentiel $V(M)$ généré en M par les deux câbles. On fixera le potentiel nul en O.
- Simplifier l'expression en considérant $r \gg D$ (champ lointain) pour l'exprimer en fonction des coordonnées polaires (r, θ) de M.
- 3 – En déduire l'expression du champ électrique en M en coordonnées polaires.
- 4 – Quelle est l'expression du champ électrique E_0 au pied de la ligne électrique à la verticale de O.

La figure ci-contre représente quelques lignes équipotentielles dans le voisinage de la ligne électrique. Sur cette figure, l'origine de l'altitude est placée au niveau du sol et les coordonnées x et z sont exprimées en mètres.



- 5 – Les lignes équipotentielles respectent-elles les symétries du problème ?
- 6 – Déduire les ligne de champ sur la figure.
- 7 – Expliquer comment déterminer la valeur du champ électrique au pied de la ligne électrique à partir de la seule étude de ces lignes équipotentielles. Calculer cette valeur. Respecte-t-elle la législation qui limite l'exposition à des champs de 5 kV/m ?

Conduction électrique

EM402 - Propriétés comparées d'un conducteur et d'un semi-conducteur.

Un fil de cuivre de diamètre $2,0 \text{ mm}$ et de longueur 10 m est traversé par un courant électrique d'intensité $I = 5,0 \text{ A}$. La résistivité du cuivre, supposé à 60° C , vaut $2,0 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. La concentration en électrons libres vaut $n^* \approx 10^{29} \text{ m}^{-3}$.

- 1 - Calculer la résistance du fil.
- 2 - Calculer la vitesse de dérive des électrons libres.
- 3 - Calculer la tension appliquée entre les extrémités du fil et le champ électrique (supposé uniforme) dans le fil.
- 4 - Mêmes questions pour un morceau de silicium dopé, c'est-à-dire pour lequel on a fortement augmenté la concentration en porteurs de charge mobiles, par injection d'impuretés en cours de fabrication : la concentration en électrons libres vaut par exemple $n^* \approx 10^{22} \text{ m}^{-3}$.

Ce morceau de silicium, de diamètre 2 mm et de longueur 1 mm , est traversé par un courant électrique d'intensité $I = 50 \text{ mA}$. Sa résistivité, à 300 K , vaut $5 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{m}$.

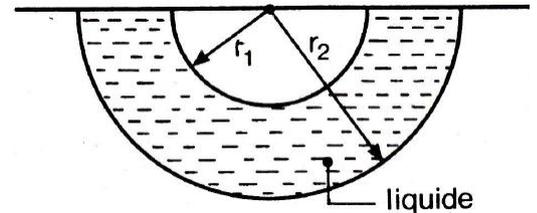
Données : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Réponses :

(1) $R = 64 \text{ m}\Omega$; (2) $v = 0,1 \text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}$; (3) $U = 0,32 \text{ V}$; $E = 32 \text{ mV}\cdot\text{m}^{-1}$
 (4) $R = 1,6 \Omega$; $v = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $U = 80 \text{ mV}$; $E = 80 \text{ mV}\cdot\text{m}^{-1}$

EM404 – Résistance de fuite d'un isolant (Yannis / Antoine)

Soit deux conducteurs en forme d'hémisphères, séparés par un liquide isolant, de résistivité ρ_f : il existe un défaut caractérisé par un courant de fuite d'intensité I_f entre les deux conducteurs de rayons r_1 et r_2 lorsqu'on applique une différence de potentiel continue U , le conducteur externe étant au potentiel nul.



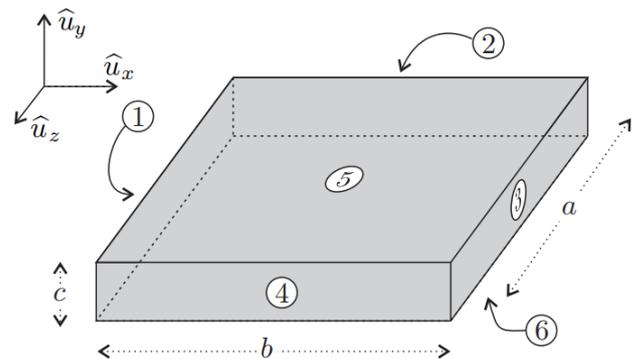
1 – Dessiner l'allure des lignes de courant de fuite lorsque U est positive. Déterminer l'expression de la résistance d'isolement R_f entre les deux conducteurs.

2 – Calculer l'intensité I_f du courant qui circule dans le liquide pour $U = 1,0 \text{ kV}$.

Données : $r_1 = 10 \text{ cm}$, $r_2 = 20 \text{ cm}$, $\rho_f = 1,0 \cdot 10^9 \Omega \cdot \text{m}$

EM406 – Effet Hall (extrait de Mines-Ponts PSI 2016) (Karl / Pierre-Alex)

L'élément principal d'une sonde à effet Hall est une plaquette constituée d'un semi-conducteur, dopé N, dans laquelle les porteurs de charges libres sont des électrons, de charge $q = -e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Leur densité volumique est $n = 3,30 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-3}$. Cette plaquette est parallélépipédique. Les six faces sont numérotées (cf figure ci-contre); ses dimensions sont $a = 3 \text{ mm}$, $b = 6 \text{ mm}$ et $c = 0,2 \text{ mm}$.



Les faces 1 et 3 sont reliées aux bornes d'une source de courant idéale, délivrant un courant d'intensité $I_0 = 10 \text{ mA}$ constante. En régime permanent, on peut considérer que les lignes de courant sont rectilignes et parallèles, orientées selon \vec{u}_x , le vecteur densité volumique de courant est uniforme et s'écrit $\vec{j} = j\vec{u}_x$.

1 - Etablir l'expression de la vitesse \vec{v} des porteurs de charge et calculer sa norme.

La plaquette est placée dans une zone de l'espace où règne un champ magnétique considéré comme constant, tel que $\vec{B} = B\vec{u}_y$ avec $B > 0$.

2 - Après avoir exprimé la force magnétique s'exerçant sur une charge mobile, justifier que des densités surfaciques de charge apparaissent sur les faces 2 et 4. On précisera les signes de ces densités.

Ces densités surfaciques de charges créent un champ électrique $\vec{E}_h = E_h\vec{u}_z$ au sein de la plaquette. En régime permanent, la vitesse des porteurs de charge reste inchangée.

3 - En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un porteur de charge, déterminer l'expression de \vec{E}_h . Montrer qu'il apparaît une différence de potentiel $u_h = V_4 - V_2$ entre les faces 4 et 2. Celle-ci est appelée tension de Hall, on l'écrira sous la forme $u_h = \gamma B$ en précisant l'expression et la valeur numérique de la constante γ .

4 – On relie les face 2 et 4 à un amplificateur différentiel utilisant un ALI idéal. Etablir la relation entre u_s et $u_h = V_4 - V_2$. A quelle condition sur R_2 et R_1 la tension de Hall est-elle amplifiée ?

7 – On choisit $R_1 = 100 \Omega$ et $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. On obtient alors $u_s = 20,0 \text{ mV}$, quelle est la valeur de B ?

